



行业动态
Industry News



台积电取得ASML超紫外光微影设备以研发新世代工艺

2010-02-26 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

TSMC与荷兰艾司摩尔(ASML)公司近日共同宣布, TSMC将取得ASML公司TWINSKAN™NXE:3100-超紫外光(ExtremeUltra-violet, EUV)微影设备, 是全球六个取得这项设备的客户伙伴之一。

这项设备将安装于TSMC的超大晶圆厂(GigaFab™)-台积电十二厂, 用以发展新世代的工艺技术。TSMC也将成为全球第一个可以在自身晶圆厂发展超紫外光微影技术的专业集成电路制造服务业者。

相较于现行浸润式微影技术以193纳米波长当作光源, 超紫外光微影技术导入更短波长的光源, 将有机会降低生产成本, 而成为集成电路制造更先进技术世代一个有潜力的选择。TSMC目前正在对超紫外光及其他微影技术的最佳成本效益的潜力进行评估。

TSMC研究发展资深副总经理蒋尚义博士表示: “TSMC将会利用ASML公司的TWINSKAN™NXE:3100设备, 进行更先进世代工艺技术的研发。超紫外光微影技术是我们正在研究的下世代微影技术之一, 而导入此项设备, 不但切合我们保持先进技术领先的目标, 更强化了我们不断投资于欧洲半导体业创新的一贯承诺。经由ASML和其他公司, 欧洲半导体业将在TSMC未来工艺技术的发展上, 继续扮演重要的角色。”

ASML公司执行副总裁暨产品及技术长Martin vanden Brink表示: “包括此次提供NXE:3100设备给TSMC, ASML已经为逻辑、动态随机存取记忆体、NAND快闪记忆体及专业集成电路制造服务等芯片制造的主要领域提供超紫外光设备。而藉由为TSMC提供未来芯片制造最佳的技术, 将可促进我们与TSMC长久的伙伴关系。”

(来源: 电子产品世界 2010年2月23日)

科普首页

微电子历史

行业动态

术语解释

无微不至

芯片制程

科普创意